МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Фізичний факультет

Кафедра загальної фізики

На правах рукопису

**Особливості світло-індукованого розпаду комплексів Fe-B у монокристалічному кремнії**

**Галузь знань:** 10 Природничі науки

**Спеціальність**: 104 Фізика та астрономія

**Освітня програма:** Фізика наносистем

**Кваліфікаційна робота магістра**

студента 2 курсу

Артем КОСТИНА

**Науковий керівник**:

доктор фізико-математичних наук,

професор, професор кафедри загальної фізики

Олег ОЛІХ

Робота заслухана на засіданні кафедри загальної фізики та рекомендована до захисту на ЕК, протокол №\_\_\_ від «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023р.

Завідувач кафедри загальної фізики проф. Микола БОРОВИЙ

Київ – 2023

**ВИТЯГ**

з протоколу №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

засідання Екзаменаційної комісії

Визнати, що студент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ виконав та захистив кваліфікаційну роботу магістра з оцінкою \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Голова ЕК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 р.

**АНОТАЦІЯ**

**Артем Костина.** Особливості світло-індукованого розпаду комплексів Fe-B у монокристалічному кремнії

*Кваліфікаційна робота бакалавра за спеціальністю 104 Фізика та астрономія, освітня програма «Фізика та астрономія». – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, фізичний факультет, кафедра загальної фізики. – Київ – 2023.*

**Науковий керівник**: доктор фізико-математичних наук, професор Олег ОЛІХ, професор кафедри загальної фізики.

Анотація Анотація Анотація Анотація Анотація Анотація Анотація Анотація Анотація Анотація Анотація Анотація Анотація Анотація Анотація Анотація Анотація Анотація Анотація Анотація Анотація Анотація Анотація Анотація Анотація Анотація

**Ключові слова**: ключові слова.

**SUMMARY**

**Shatlik ILAMANOV.** Features of light-induced disasiation of Fe-B complexes in monocrystalline silicon.

*Bachelor qualification in specialty 104 Physics and astronomy, educational program «Physics and astronomy». – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Physics, General Physics Department. – Kyiv. – 2023*.

**Research supervisor**: Doctor of Physicі and Mathematics, Professor Oleg OLIKH, Professor at General Physics Department.

Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract

**Key words**: key words.

**ЗМІСТ**

[ВСТУП 4](#_Toc131580593)

[Розділ 1. Огляд літератури 5](#_Toc131580594)

[1.1. 5](#_Toc131580595)

[1.2. 5](#_Toc131580596)

[1.3. 5](#_Toc131580597)

[Розділ 2. Методика експерименту 6](#_Toc131580598)

[2.1 Експериментальна установка 6](#_Toc131580599)

[2.2 Результати калібрування джерел світла 6](#_Toc131580600)

[2.3 Зразки 8](#_Toc131580601)

[Розділ 3. Отримані результати 9](#_Toc131580602)

[3.1 Особливості реалізації лабораторної роботи 9](#_Toc131580603)

[Висновки 10](#_Toc131580604)

[Список використаних джерел 11](#_Toc131580605)

# ВСТУП

# Розділ 1. Огляд літератури

## 1.1.

## 1.2.

## 1.3.

# Розділ 2. Методика експерименту

## 2.1 Експериментальна установка

## 2.2 Результати калібрування джерел світла

Для світло-індукованої дисоціації пар FeB використовувалися 3 потужні галогенові лампи різних виробників. А саме

Haltlichtspiegel 52240.0, 24 В, 200 Вт – надалі її позначатимемо Orion;

Osram 64653 HLX ELC, 24 В, 250 Вт (Osram);

General Electric 43537 H271, 20 В, 150 Вт (GE).

Калібрування випромінювання цих джерел здійснювалося на виході світловоду, тобто оцінювався світловий потік, який безпосередньо потрапляв на зразок. Для живлення ламп використовувалося регулюване джерело живлення ITECH IT6332В, яке дозволяло встановити струм, що протікає через лампу з точністю до 1 мА. Калібрування за інтегральною потужністю випромінювання Will здійснювалося за допомогою цифрового вимірювача оптичної потужності та енергії THORLABS PM100D; при цьому використовувався широкосмуговий датчик S401C (вхідний діапазон 0,19-20 мкм, максимальна вхідна оптична потужність – 1 Вт). Були проведені вимірювання оптичної потужності як функції сили струму, що споживає лампа Il – див. рис.2.3. Як видно, максимальна потужність світлового потоку для GE може досягати 400 мВт, для Osram – 800 мВт, для Orion – 1 Вт. Надалі під час освітлення зразків інтегральна інтенсивність контролювалася саме за величиною споживаного струму.

|  |
| --- |
|  |
| Рис.2.3 Калібрувальні криві використаних джерел освітлення. |

Спектр випромінювання використаних ламп вимірювався за допомогою монохроматора МСД12 з використанням ФЕП40 з Пельт’є охолодженням. Так на рис.2.3 наведено залежності спектральної випромінювальної здатності ωill лампи Osram при різних інтегральних інтенсивностях. Наведені дані є типовими для всіх використаних ламп і відображають основні особливості, а саме: 1) фактично все випромінювання знаходиться в діапазоні 400-800 нм; 2) при збільшенні Will спостерігається зсув спектру у короткохвильову область.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Рис.2.4 Спектри випромінювання лампи Osram при різних інтегральних інтенсивностях (а) та їх нормовані значення (б) | |

З іншого боку, спектри різних ламп не тотожні (див. рис.2.5) і відрізняються як положенням максимуму випромінювальної здатності так і внесками довгохвильової та короткохвильової компонент.

|  |
| --- |
|  |
| Рис.2.5 Спектри випромінювання використаних джерел при однаковій інтегральній потужності |

## 2.3 Зразки

Для досліджень було використано кремнієві сонячні елементи (КСЕ) дифузійно-польового типу зі структурою *n+-p-p+*, структура яких показана на рис. 2.6. Для їхнього виготовлення використовувалися монокристалічні пласнини кремнію КДБ10 товщиною 380 мкм. Р-n та антирекомбінаційний ізотипний переходи були сформовані шляхом дифузії фосфору та бору з газової фази, відповідно. Товщини n+- та p+ шарів складали 0,7 та 0,6 мкм відповідно, їхні опори ‑ 20-30 Ом/ та 10-20 Ом/. На фронтальній поверхні KСЕ були наявні також просвітлюючі покриття з двоокису кремнію SiO2 товщиною 30 нм і нітриду кремнію Si3N4 товщиною 40 нм. В експериментах використовувалися зразки розміром 1,52×1,523 см2. Тестові вимірювання проводилися на трьох різних зразках; основний масив даних отримано для зразка з максимальною концентрацією заліза (близько 9⋅1012 см-3).

|  |
| --- |
|  |
| Рис.2.6 Схема КСЕ. 1 – фронтальний електрод (Al); 2 – шар нітриду кремнію; 3 ‑ діелектричний шар SiO2; 4 – індукований n++-шар; 5 – дифузійний n+- шар;6 – базова область (*р*-Si); 7 – дифузійний *р*+-шар; 8 – тилова металізація (Al) |

# Розділ 3. Отримані результати

## 3.1 Визначення темпу дисоціації пар FeB

Як вже зазначалося раніше, основними дефектами, пов’язаними з домішковим залізом у монокристалічному кремнії, легованому бором, є міжвузольні атоми Feі та пари FeiBs. Причому за рівноважних умов більшість атомів заліза будуть утворювати пари, а залишкова рівноважна кількість неспарених атомів *N*Fe,eq суттєво залежатиме від температури [1]. Зокрема, при 340 К *N*Fe,eq складає близько 10% від загальної атомів заліза *N*Fe,tot в кристалі

Кількісна умова рівноваги між концентрацією міжвузольних атомів заліза та парами FeB може бути визначена за допомогою наступних реакцій

, (2.20)

де

*Ra* = τass-1 та *Rd* – темпи асоціації та дисоціації пари FeB, відповідно, с-1. Виходячи з рівнянь (2.20) та взявши до уваги, що *N*Fe = *N*Fe,tot – *N*FeB та *N*Fe(*t*ill = 0) = *N*Fe,eq, можна отримати часову залежність концентрації міжвузольних атомів під час інтенсивного освітлення:

. (2.21)

Порівняння виразів (2.13) та (2.21) показує, що

 (2.22)

## 3.2 Залежність світло-індукованого розпаду комплексів Fe-B від спектрального складу освітлення

# Висновки

1. Розроблена методика проведення лабораторної роботи, спрямованої на вимірювання вольт-амперних характеристик з використанням мікроконтролерної плати Arduino. Проведено підбір необхідних елементів, а саме визначено доцільність використання цифро-аналогового перетворювача MCP4725 та монітору INA226.

2. Підготовлена програма для мікроконтролера та виготовлено прототип лабораторної роботи.

3. Створено опис роботи та проведено тестування обладнання.

# Список використаних джерел